

2SB857, 2SB858

シリコン PNP 三重拡散形

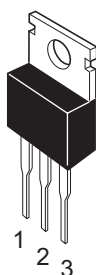
HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用
- 2SD1133, 2SD1134 とコンプリメンタリペア

外観図

TO-220AB



1. Base
2. Collector (Flange)
3. Emitter

絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SB857	2SB858	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-70	-70	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-50	-60	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	-5	V
コレクタ電流	I_C	-4	-4	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	-8	-8	A
許容コレクタ損失	P_C^*	40	40	W
接合部温度	T_j	150	150	°C
保存温度	T_{stg}	-45~+150	-45~+150	°C

【注】 1. $T_C = 25^\circ\text{C}$ における許容値

電気的特性

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SB857			2SB858			単位	測定条件
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	-70	—	—	-70	—	—	V	$I_C = -10\mu\text{A}, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	-50	—	—	-60	—	—	V	$I_C = -50\text{mA}, R_{BE} = \infty$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	-5	—	—	-5	—	—	V	$I_E = -10\mu\text{A}, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	-1	—	—	-1	μA	$V_{CB} = -50\text{V}, I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	60	—	320	60	—	320		$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}^{*2}$
	h_{FE2}	35	—	—	35	—	—		$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -0.1\text{A}^{*2}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	-1	—	—	-1	V	$I_C = -2\text{A}, I_B = -0.2\text{A}^{*2}$
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	—	-1	—	—	-1	V	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}^{*2}$
利得帯域幅積	f_T	—	15	—	—	15	—	MHz	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -0.5\text{A}^{*2}$

【注】 1. 2SB857, 2SB858 は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

B	C	D
60~120	100~200	160~320

2. パルス測定

